	173	Зона	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
Терв. примен.	E1 1006 75897 HF34			Конденсаторы		
J/E	PEYH.		<i>C3-C5</i>	GRM21BR71H104KA01K, фирма Murata Manufacturing, Япония	3	имп. изд.
			<i>C6,C7</i>	GRM21BR71H105KA12L, фирма Murata Manufacturing, Япония	2	имп. изд.
			C8-C11	GRM21BR71H104KA01K, фирма Murata Manufacturing, Япония	4	имп. изд.
			C12,C13	GRM21BR71H154K, фирма Murata Manufacturing, Япония	2	имп. изд.
o/			C14	GRM21BR71H105KA12L, фирма Murata Manufacturing, Япония	1	имп. изд.
Cnpaß. Nº			C15	GRM21BR71H104KA01K, фирма Murata Manufacturing, Япония	1	имп. изд.
(U)			C16-C23	CL31B225KBHNNNE, фирма Samsung, Япония	8	имп. изд.
			C24,C25	GRM21BR71H104KA01K, фирма Murata Manufacturing, Япония	2	имп. изд.
			C26,C27	ССО805KRX7R9BB472, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
			C28,C29	ССО805JRNP09BN470, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
			C30-C41	CL32B226KOJNNNE, фирма Samsung, Япония	12	имп. изд.
Z			C42-C49	CL31B225KBHNNNE, фирма Samsung, Япония	8	имп. изд.
дат.			C50,C51	GRM21BR71H104KA01K, фирма Murata Manufacturing, Япония	2	имп. изд.
одп. и дата			C52,C53	GRM216R71H822KAO1D, фирма Murata Manufacturing, Япония	2	имп. изд.
71/			C54,C55	CL21C5R6CBANNNC, фирма Samsung, Япония	2	имп. изд.
ТΩ			<i>C56-C67</i>	CL32B226KOJNNNE, фирма Samsung, Япония	12	имп. изд.
Nº de						
Инв. № дубл.				Микросхемы		
). No						
л. Взам. инв. №			DA1	L 78L33ABUTR, фирма STMicroelectronics, Швейцария	1	имп. изд.
Вза						
та Вэ						
и да						
т. Подп. и дата		1	Bce PEYH.1-	1 <i>33</i> .	<i>T</i>	
		Изм. Раз	Лист № до. раб. Подлес		Тист Листов	
Инв. № подл.		Про	в. Шавлик	rob nodn. 08.06.23	71	1 5
N GH		Н. к	и.отд. Гонтр. Мироші			
*		Ymt	б. Шавлик	(ОВ ПОДП. 08.06.23 ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕПЕННОО Копиповал:		Фолмат 44

Копировал

Зона	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
	DD1,DD2	VN5016AJTR-E, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	<i>ИМП. ИЗ</i> Ф.
	DD3	SN74HC125DR, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды	1	имп. изд.
	DD4	LTC2954ITS8-2, фирма Analog Devices, США	1	имп. изд.
	DD5-DD8	TPS54560DDAR, фирма Texas Instruments, США	4	имп. изд.
		Предохранители плавкие		
	FU1	189000.15, фирма SIBA, Германия	1	<i>ИМП. ИЗ</i> д.
	FU2	KLS5–1046–25000, фирма KLS electronic, Kumaū	1	имп. изд.
	FU3,FU4	MF-MSMF050, фирма Bourns, США	2	имп. изд.
		Катушки индуктивности		
	L1,L2	B82477G4153M000, фирма EPCOS, Германия	2	имп. изд.
	<i>L3</i>	B82477G4333M000, фирма EPCOS, Германия	1	имп. изд.
	<i>L4</i>	B82477G4823M000, фирма EPCOS, Германия	1	имп. изд.
		Резисторы		
	R1,R2	RCO805FR-07100RL, фирма Yageo, Тайвань	2	<u>имп. изд.</u>
	R3-R6	RCO805FR-0710KL, фирма Yageo, Тайвань	4	имп. изд.
	<i>R7,R8</i>	RCO805FR-072K7, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
	R9,R10	RCO805FR-077K5 фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
	R11-R14	RCO805FR-0710KL, фирма Yageo, Тайвань	4	имп. изд.
	R15,R16	RCO805FR-07100RL, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
	R17,R18	RCO805FR-0710KL, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
	R19	1	имп. изд.	
	R20	RCO805FR-0710KL, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	Лист № до.	РЕУН.468349.001 П.3 кум. Подп. Дата	73 75	7

Зана	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
	R21	RC0805FR-07100RL, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R22,R23	RCO805FR-0710KL, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
	R24	RCO805FR-07100KL, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R25	RCO805FR-07100RL, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R26,R27	RCO805FR-070RL, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
	R28,R29	RCO805FR-07243KL, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
	R30,R31	RCO805FR-0716K9L, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
	R32,R33	RC0805FR-07330RL, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
	R34	RCO805FR-0753K6L, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R35	RCO805FR-0710K2L, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R36	RC0805FR-0753K6L, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R37	RCO805FR-0710K2L, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R38,R39	RCO805FR-070RL, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
	R40,R41	RCO805FR-07243KL, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
	R42,R43	RC0805FR-0723K7L, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
	R44,R45	RCO805FR-071K2, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
	R46	RCO805FR-07143KL, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R47	RCO805FR-0710K2L, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R48	RCO805FR-07143KL, фирма Yageo, Taūbaнь	1	имп. изд.
	R49	RCO805FR-0710K2L, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
		Диоды		
	VD1-VD4	SM15T36A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	4	имп. изд.
	VD5, VD6	ТО-1608BC-PG, фирма Таіwan Oasis Technology, Китай	2	имп. изд.
	VD7,VD8	РМЕG3010BEA,115, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды	2	имп. изд.
	VD9, VD10	SMAJ15A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	имп. изд.
	VD11, VD12	SMAJ24A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	имп. изд.
Изм.	/lucm № do	РЕУН.468349.001 ПЭ_ кум. Подп. Дата	3 75	7 Jucin

Копировал

	Зона	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
		1/0121/014	DECDENOIADA AAE A NVD C ' L L L J J J	2	7
		VD13, VD14	PESD5VOL1BA,115, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды		<u>имп. изд.</u>
		VD15	TO-1608BC-PG, фирма Taiwan Oasis Technology, Китай	1	<u>ИМП. ИЗ</u> Д.
		VD16, VD17	B560C, фирма Diodes Incorporated, США	2	<u>имп. изд.</u>
		VD18, VD19	TO-1608BC-PG, фирма Taiwan Oasis Technology, Китай	2	<u>имп. изд.</u>
		VD20, VD21	SMBJ5.A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	<u>имп. изд.</u>
		VD22, VD23	B560C, фирма Diodes Incorporated, США	2	<u>имп. изд.</u>
		VD24, VD25	TO-1608BC-PG, фирма Taiwan Oasis Technology, Китай	2	<u>имп. изд.</u>
		VD26, VD27	SMBJ12A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	имп. изд.
			Транзисторы		
		VT1,VT2	IRF7509TRPBF, фирма Infineon Technologies, Германия	2	имп. изд.
		VT3,VT4	BSH103,215, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды	2	имп. изд.
Подп. и дата			Соединения контактные		
Nodi		X1,X2	XT60-M.G2.Y, фирма Amass Electronics, Китай	2	<i>имп. изд.</i>
1001		X3-X8	DS1066-2MVW6X, фирма Connfly, Китай	6	имп. изд.
Инв. № дудл.		X9-X12	DS1069-4MVW6X, фирма Connfly, Китай	4	имп. изд.
ZHQ.		X13,X14	XT60-F.G2.Y, фирма Amass Electronics, Китай	2	имп. изд.
HD. Nº		X15,X16	DS1066-2MVW6X, фирма Connfly, Китай	2	имп. изд.
Взам. инб. №					
Іодп. и дата					
/lodir.					
חסטת					
VIHD. N° NOGA.	Изм	/lucm Nº đor	<u>РЕУН.468349.001 ПЭЗ</u>	3 T <del>3</del>	, / <i>Jucm</i> 4

	Номера листов (страниц)				Всего		Dvodawwi yayan		
Изм.	UЗМЕ- НЕН- НЫХ	3ДМС- НСН- НЫХ	новых	аннули– рован– ных	листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дат
		-							
		1							
		1							
		<u> </u>							
		<u> </u>							
		-							
		<u> </u>							
		<u> </u>							
		1							
		<u> </u>							
		1							
		1							
		1							
			<u> </u>						
			-+			PFUH I. K	8349.001 [733	<i>T</i> 7	Λu
Изм.	Лист	№ док	ГУМ.	Подп.	Дата	Konupobi		ע ו	